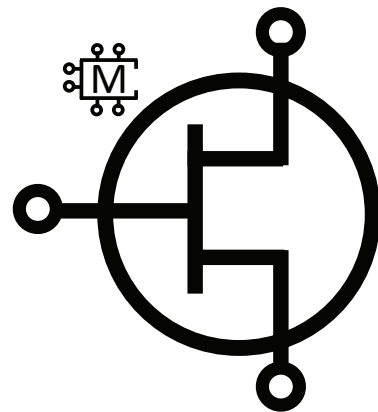


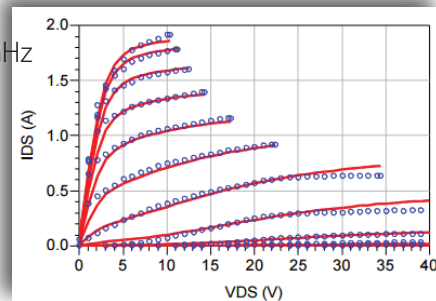
ModelithicsのノンリニアGaN HEMTモデリングサービスは、Modelithicsの測定技術と既の実績のあるGaNモデル化の専門知識により、高精度な測定と高度なモデルにスケーラビリティ機能を備えたサービスで、既に米国GaN大手及び日本国内のGaNデバイスメーカー2社でモデリング実績がある。今回その技術を元にデバイスの高精度なキャラクタリゼーション、モデルティクスの詳細なプロセスと様々なトポロジを、一つのパッケージサービスとして、業界標準のEDAソフトウェアのモデルとライブラリ化をサービスとして実施。



I-V

デバイス測定技術

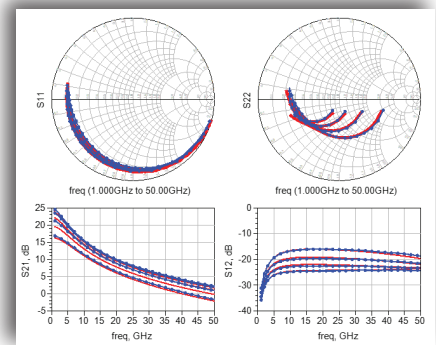
- MMIC及びパッケージデバイス
- Sパラメータ測定 (30KHz~170GHz)
- 大電力パルス I-V特性 (最大30A)
- 温度依存性測定 (-55~+200°C)
- 非線形ロードプル測定 (0.2GHz~50GHz)
周波数範囲は、顧客のご要求で設定
- オンウェファ及びオンボード測定
- インピーダンス測定：ESR、CV、Q to 3GHz
- Xパラメータ測定 (最大67GHz)
- パルスバイアスSパラメータ
- ノイズパラメータ測定 (~50GHz)



バイアス依存Sパラメータ

提供物

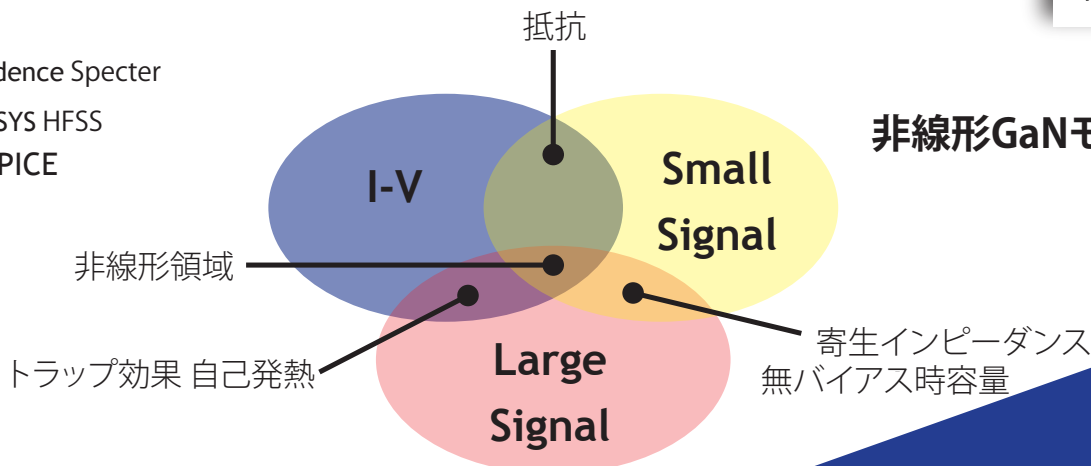
- 正確な信号性能
- 高精度大信号モデル
- 波形解析用I-V測定モデル
- 静止バイアス測定 (GaNのトラップ効果考慮モデル)
- 低周波及び高周波ノイズ挙動測定
- セルフヒートモデル 自己発熱モデル
- バイアス依存モデル
- 温度依存モデル
- ワイヤーボンダーエンベデッドモデル
- 詳細なモデルのデータシート
- パッケージ部品及びダイの両GaNモデル



対象EDA

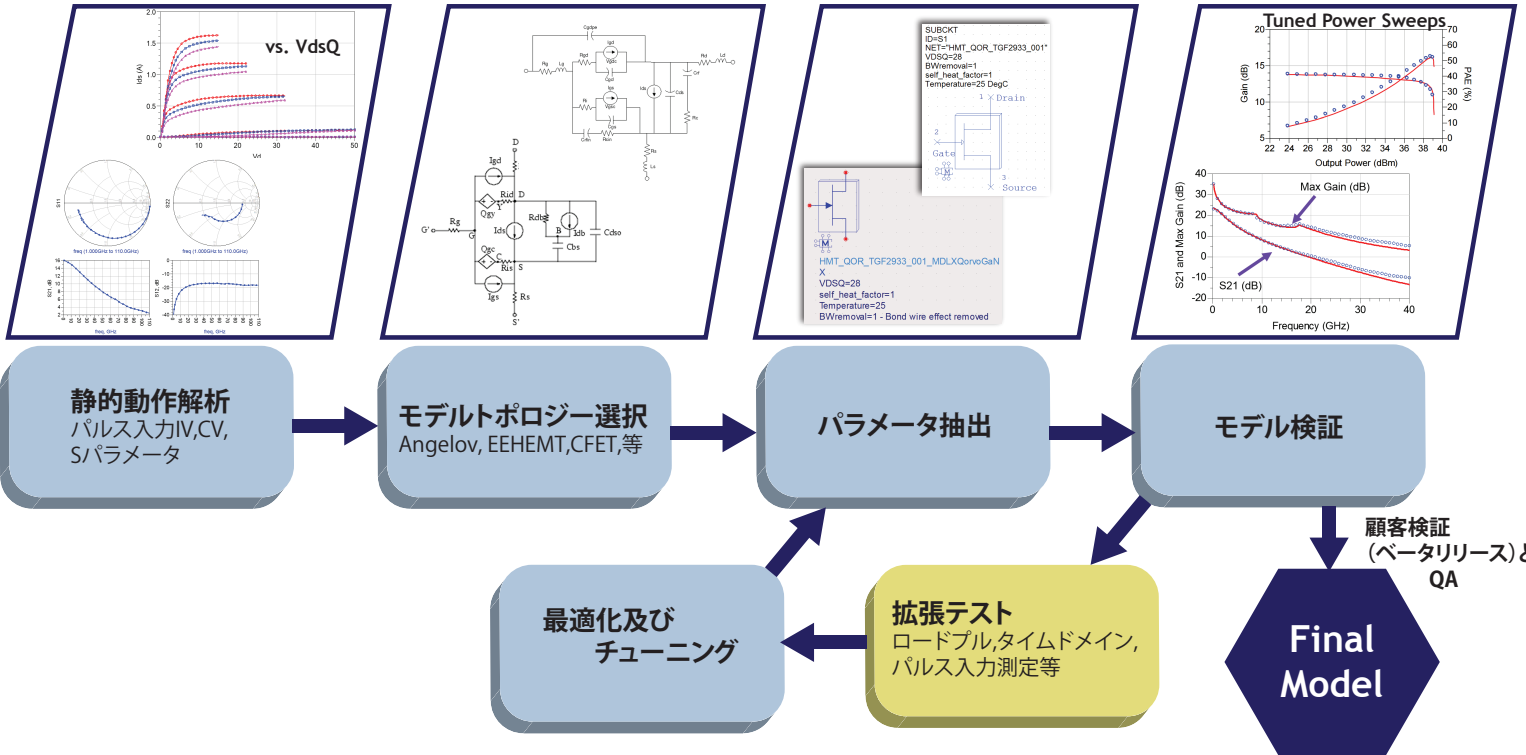
- Keysight社：Advanced Design System (ADS) 及びGenesys
- NI AWR社：AWRDE

- Cadence Specter
- ANSYS HFSS
- PSPICE

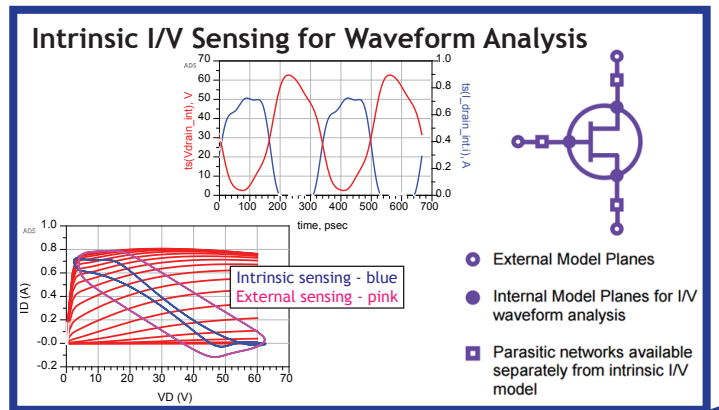
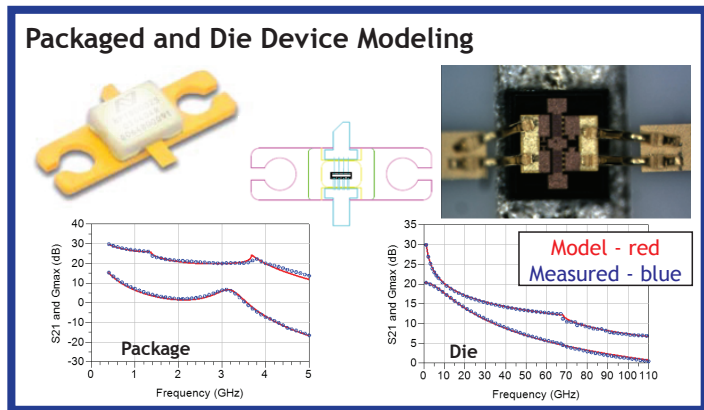
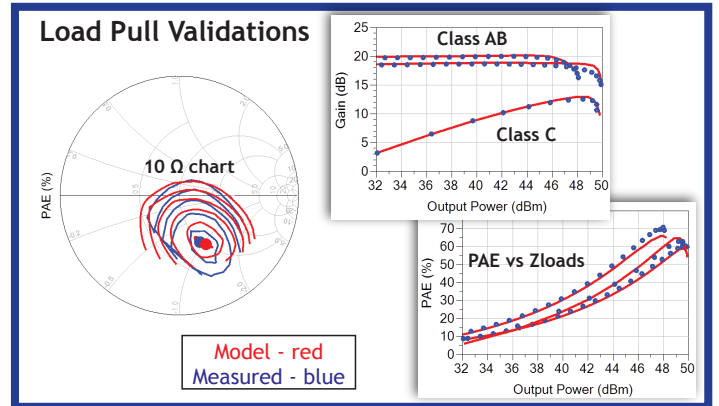
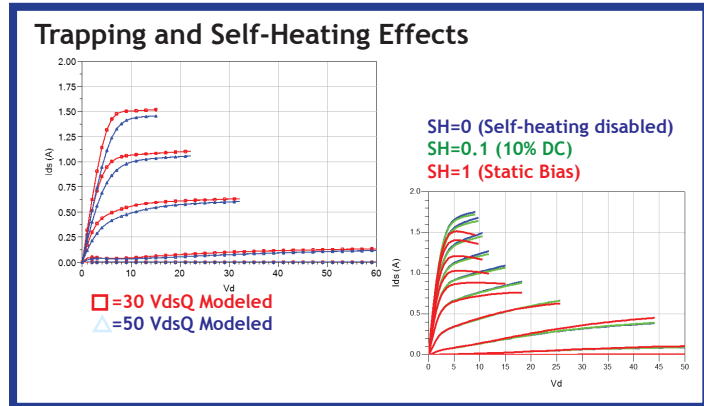


非線形GaNモデル

非線形モデリングプロセス



モデリックス社GaNモデル性能



株式会社アイ・エム・シー
 TEL : 03-6908-9363 FAX : 03-6908-9369
 WEBお問い合わせフォーム :
<https://s1.coressl.jp/www.im-c.co.jp/inquiry/form.html>
 E-mail : imc.info@im-c.co.jp